



岩



**半导体分立器件
LYPM9540G 型大功率 P 沟道场效应
晶体管产品手册**

济南晶恒电子有限责任公司

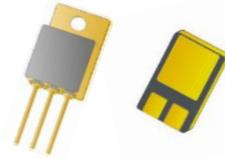
V1.0



LYPM9540G 型大功率 P 沟道 MOS 场效应晶体管

1 产品概述

LYPM9540G 是大功率 P 沟道场效应晶体管之一，采用 VDMOSFET 工艺制造。在整机电子线路中具有放大、开关作用，也可用作动态阻抗和恒流源等。



TO-257 型 SMD-0.5 型

2 ZZKK 情况

LYPM9540G 型大功率 P 沟道场效应晶体管为我单位自主研发产品，其关键原材料和零部件、设计开发、工艺制造、产品检测与供应均满足 ZZKK 要求。

3 特性

可提供 SMD-0.5 金属陶瓷封装和 TO-257 型通孔插装。

具有开关速度快、损耗小，输入阻抗高，驱动功耗小安全工作区宽，温度稳定性好的特点。

器件的静电放电敏感度为人体模式 1C 级，1000V。SMD-0.5 型封装的典型重量为 1.0g；TO-257 型封装典型重量 4.3g。

4 可提供质量等级

J 级；

G、G+级：Q/RBJ1005QZE-2024。

5 最大额定值

最大额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^\circ\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

参数 名称	封装 型号	TO-257	SMD-0.5	单位
		LYPM9540 (R) GT	LYPM9540 (R) GU	
额定功率 P_D ($T_c=25^\circ\text{C}$)		75	75	W
漏极电流 I_{DM1} ($T_c=25^\circ\text{C}$)		-18	-18	A
漏极电流 I_{DM2} ($T_c=100^\circ\text{C}$)		-11	-11	A
栅源电压 V_{GS}		±20	±20	V
热阻 R_{thjc}		1.67	1.67	°C/W

6 主要电特性

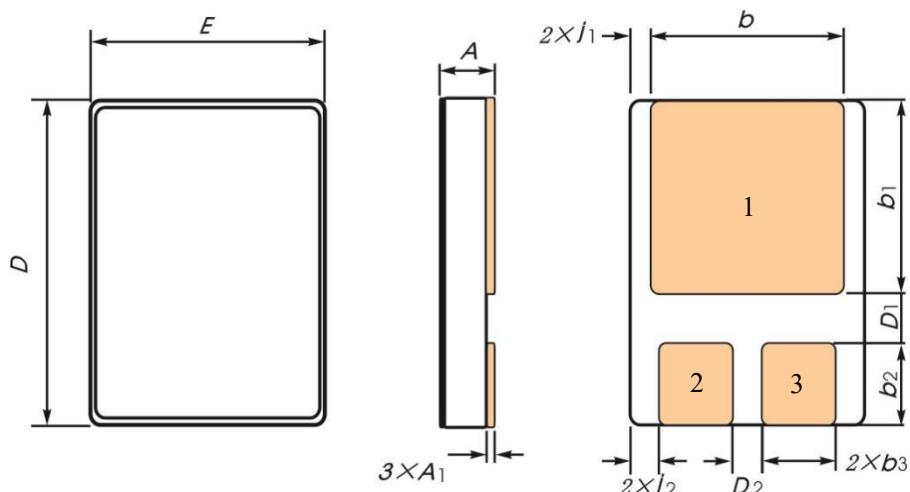
主要电特性（除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}\pm3^{\circ}\text{C}$ ）见表 2。

表 2 主要电特性

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小值	典型值	最大值	
导通电阻	$R_{DS(\text{ON})}$	$V_{GS}=-10\text{V}$, $I_D=I_{DM2}$	—	0.100	0.117	Ω
漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS}=0\text{V}$, $I_D=-0.25\text{mA}$	-100	-105	—	V
阈值电压 ^a	$V_{GS(\text{th})}$	$V_{DS}=V_{GS}$, $I_D=-0.25\text{mA}$	-2.0	-3.5	-4.0	V
零栅压漏极电流	I_{DSS}	$V_{DS}=0.8BV_{DSS}$, $V_{GS}=0\text{V}$	—	—	-25	μA
正向栅极漏电流	I_{GSSF}	$V_{GS}=-20\text{V}$	—	—	-100	nA
反向栅极漏电流	I_{GSSR}	$V_{GS}=20\text{V}$	—	—	100	nA

注：^a建议阈值电压 8V 以上，导通电阻随阈值电压升高逐渐减小。

7 外形尺寸



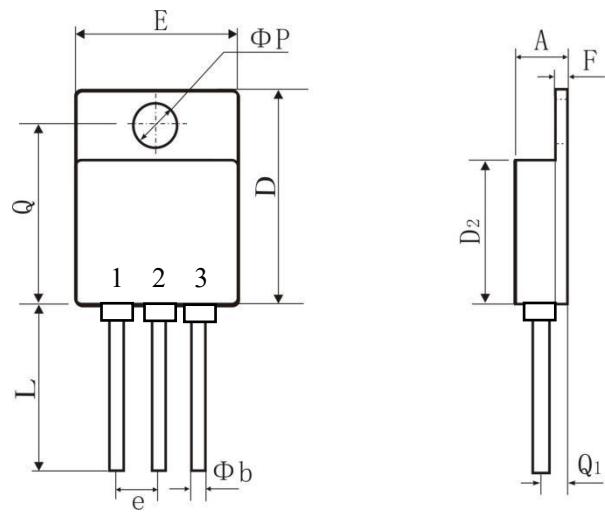
注：LYPM9540GU 引出端极性：1-D, 2-S, 3-G；

LYPM9540RGU 引出端极性：1-D, 2-G, 3-S；

单位为毫米

尺寸符号	数 值		尺寸符号	数 值	
	最 小	最 大		最 小	最 大
A	—	3.15	D	9.94	10.45
A_1	0.15	0.61	D_1	0.60	—
b	6.92	7.57	D_2	0.70	—
b_1	5.49	5.94	E	7.30	7.81
b_2	2.83	3.27	j_1	—	0.35
b_3	2.19	2.64	j_2	0.15	0.87

图 1 SMD-0.5 型封装外形尺寸



注: LYPM9540GT 引出端极性: 1-G, 2-D, 3-S;
LYPM9540RGT 引出端极性: 1-D, 2-S, 3-G。

单位为毫米

符号 尺寸	A	Φb	D	D_2	E	e	F	L	ΦP	Q	Q_t
最小值	4.73	0.64	16.30	10.40	10.40	2.24	0.70	10.20	3.35	12.80	2.75
最大值	5.23	1.05	16.89	10.97	10.97	2.84	1.14	15.88	3.75	14.19	3.35

图 2 TO-257 外形尺寸

8 典型应用

该产品为单极型的电压控制器件，在电子线路中主要起开关或放大作用，典型的开关电路如图 3。

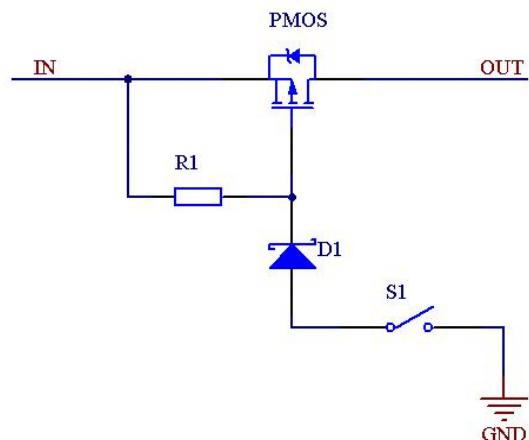


图 3 典型开关电路



9 注意事项

产品手册将不定期更新, 请用户务必在使用我单位产品前通过官方渠道
获取产品手册的最新版本, 对产品手册有疑问之处请与我单位联系。

9.1 降额设计

- a) 线路设计应保证与额定值比有足够的余量;
- b) 器件使用时最大结温不超过 150°C, 环境温度不超过 -55°C~125°C。

9.2 产品使用和防护

- a) 器件应在防静电的工作台上操作;
- b) 试验设备和器具应接地;
- c) 不能直接用手触摸器件引线, 应佩戴防静电指套和腕带;
- d) 器件的存放、生产、测试、使用及流转过程工作区域内应避免使用能引起静电的塑料、橡胶或丝织物。

9.3 产品焊接

镀金引线或焊端均应进行除金处理, 不允许在镀金引线或者焊端上直接焊接。可以使用手工焊接、回流焊接两种焊接方式, 手工焊接温度不超过 260°C, 焊接时间不超过 10s。使用回流焊炉推荐使用约 183°C 的低熔点焊料焊接, 在保证焊接质量的情况下, 峰值温度可以适当降低, 典型的回流焊接温度工艺曲线如图所示。

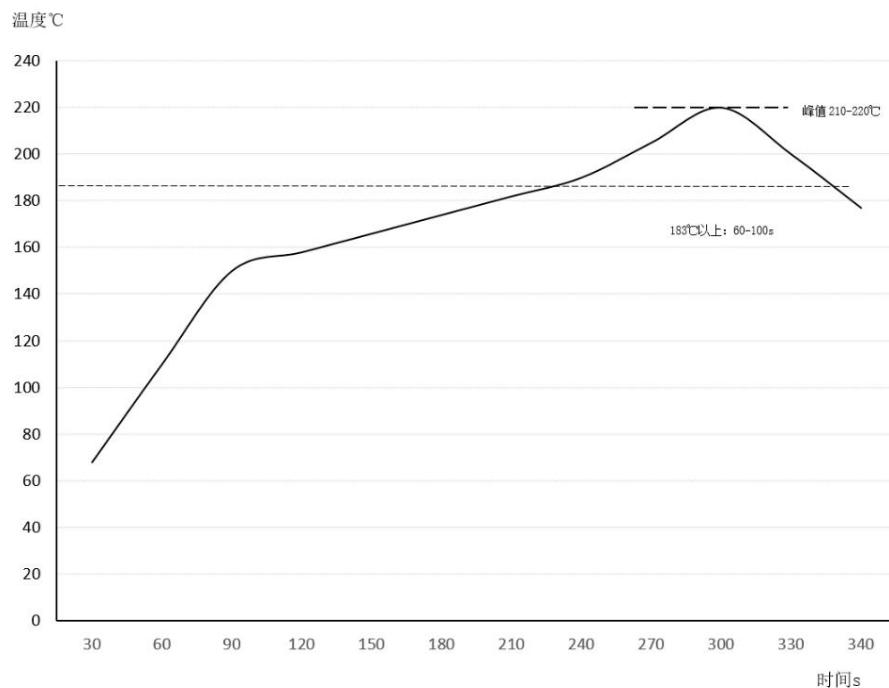


图 4 建议的回流焊曲线

9.4 产品贮存

应将包装好的产品应贮存在环境温度为 16°C~28°C, 相对湿度为 30%~70%, 周围没有酸、碱或其它腐蚀性气体且通风良好的库房里。

9.5 引线成型

TO-257 型封装产品引线属于刚性引线, 不建议弯腿使用。



10 可能的失效模式

序号	可能的失效模式	失效情况	失效的条件	可能造成产品失效的原因	使用注意事项
1	过应力烧毁	漏源间 PN 结击穿或开路、芯片铝引线粗糙、发黑，严重者熔断	器件引入过高应力，超出器件安全工作区，引起器件温升过高，造成参数退化或烧毁	设备自激震荡；器件串入高压信号；环境温度升高后，没有采取降温措施	不超过额定值及安全工作区
2	短路	漏源、漏栅和栅源之间短路	器件过电流或者过功率烧毁	过电流应用；过功率应用	不超过额定值及安全工作区
3	开路	漏源开路、栅源开路	过电流导致压焊丝熔断	外部电路振荡引入过大电流	抑制外部电路振荡，保证器件不超过额定值及安全工作区
4	静电损伤	漏源、漏栅和栅源之间短路，漏源开路、栅源开路	器件过电流或者过功率烧毁，过电流导致压焊丝熔断	筛选、测试、安装及运输过程中引入的静电	采取接地等防静电措施

11 生产厂信息

通信地址：济南市长清区平安街道经十西路 13856 号晶恒工业园

技术咨询 电话：0531-87225289 传真：0531-86593255

电话：0531-86593255 传真：0531-86593255

销售业务（华北、东北） 电话：0531-86593275 传真：0531-86990345

销售业务（华东、中南） 电话：0531-86593250 传真：0531-86990345

销售业务（西北、中原） 电话：0531-86593253 传真：0531-86990345

销售业务（西南、华南） 电话：0531-86593150 传真：0531-86990345